

EasyPACK™ 模块采用 CoolSiC™ Trench MOSFET 带有 PressFIT 压接管脚和温度检测 NTC / TIM

特性

- 电气特性
 - $V_{DSS} = 1200\text{ V}$
 - $I_{DN} = 100\text{ A} / I_{DRM} = 200\text{ A}$
 - 高电流密度
 - 低开关损耗
- 机械特性
 - 集成的安装夹使安装坚固
 - 集成 NTC 温度传感器
 - PressFIT 压接技术
 - 预涂导热介质



Typical appearance

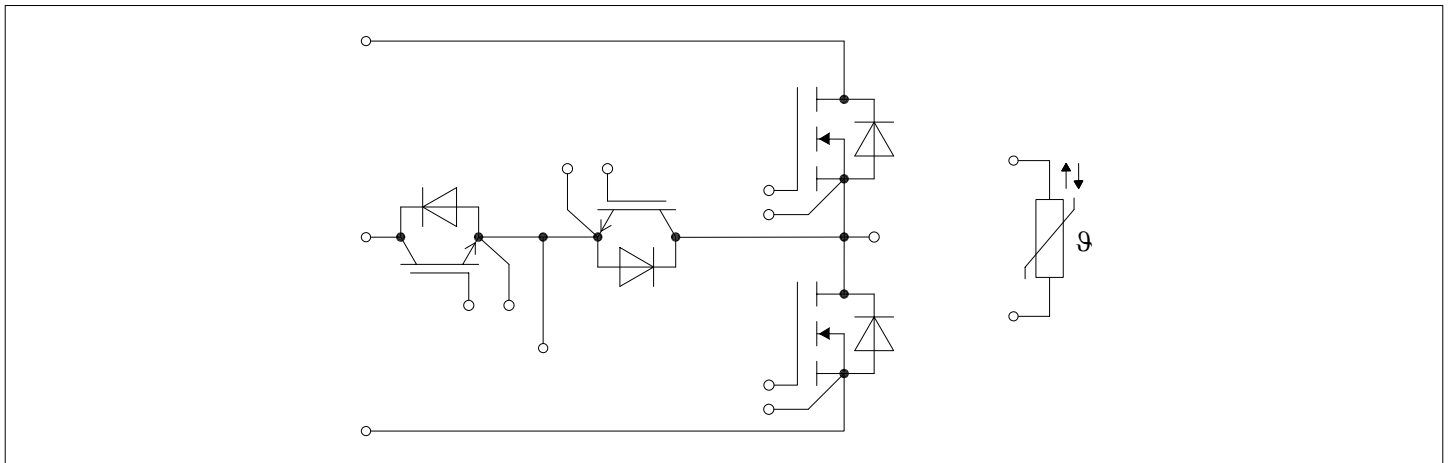
可选应用

- 太阳能应用
- 三电平应用
- 电动车直流充电

产品认证

- 根据 IEC 60747、60749 和 60068 标准的相关测试，符合工业应用的要求。

描述



内容

	描述.....	1
	特性.....	1
	可选应用.....	1
	产品认证.....	1
	内容.....	2
1	封装.....	3
2	MOSFET	3
3	Body diode	5
4	IGBT, 三电平	6
5	二极管, 三电平.....	7
6	负温度系数热敏电阻.....	8
7	特征参数图表.....	9
8	电路拓扑图.....	18
9	封装尺寸.....	19
10	模块标签代码.....	20
	修订历史.....	21
	免责声明.....	22

1 封装

1 封装

表 1 绝缘参数

特征参数	代号	标注或测试条件	数值	单位
绝缘测试电压	V_{ISOL}	RMS, $f = 50 \text{ Hz}$, $t = 60 \text{ s}$	3.0	kV
内部绝缘		基本绝缘 (class 1, IEC 61140)	Al_2O_3	
爬电距离	d_{Creep}	端子至散热器	11.5	mm
爬电距离	d_{Creep}	端子至端子	6.3	mm
电气间隙	d_{Clear}	端子至散热器	10.0	mm
电气间隙	d_{Clear}	端子至端子	5.0	mm
相对电痕指数	CTI		>200	
相对温度指数 (电)	RTI	封装	140	°C

表 2 特征值

特征参数	代号	标注或测试条件	数值			单位
			最小值	典型值	最大值	
杂散电感, 模块	L_{SCE}			12		nH
模块引线电阻, 端子-芯片	$R_{CC'+EE'}$	$T_H = 25^\circ\text{C}$, 每个开关		0.4		mΩ
储存温度	T_{stg}		-40		125	°C
最高基板工作温度	T_{BPmax}				125	°C
Mounting force per clamp	F		40		80	N
重量	G			39		g

注: The current under continuous operation is limited to 25 A rms per connector pin.
Storage and shipment of modules with TIM => see AN2012-07.

2 MOSFET

表 3 最大标定值

特征参数	代号	标注或测试条件		数值	单位
漏源极电压	V_{DSS}		$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	1200	V
植入漏极电流	I_{DN}			100	A
连续漏极直流电流	I_{DDC}	$T_{vj} = 175^\circ\text{C}$, $V_{GS} = 18 \text{ V}$	$T_H = 65^\circ\text{C}$	85	A
漏极重复峰值电流	I_{DRM}	verified by design, t_p limited by T_{vjmax}		200	A
栅-源瞬态最大电压	V_{GS}	$D < 0.01$		-10/23	V
栅-源稳态最大电压	V_{GS}			-7/20	V

表 4 推荐值

特征参数	代号	标注或测试条件	[ZH]Values	单位
通态栅极电压	$V_{GS(on)}$		15...18	V
断态栅极电压	$V_{GS(off)}$		-5...0	V

表 5 特征值

特征参数	代号	标注或测试条件		数值			单位
				最小值	典型值	最大值	
漏源通态电阻	$R_{DS(on)}$	$I_D = 100\text{ A}$	$V_{GS} = 18\text{ V}, T_{vj} = 25\text{ °C}$		8.1	12	mΩ
			$V_{GS} = 18\text{ V}, T_{vj} = 125\text{ °C}$		13.1		
			$V_{GS} = 18\text{ V}, T_{vj} = 175\text{ °C}$		17.4		
			$V_{GS} = 15\text{ V}, T_{vj} = 25\text{ °C}$		9.7		
栅极阈值电压	$V_{GS(th)}$	$I_D = 40\text{ mA}, V_{DS} = V_{GS}, T_{vj} = 25\text{ °C},$ (tested after 1ms pulse at $V_{GS} = +20\text{ V}$)		3.45	4.3	5.15	V
栅极电荷	Q_G	$V_{DS} = 800\text{ V}, V_{GS} = -3/18\text{ V}$			0.297		μC
内部栅极电阻	R_{Gint}	$T_{vj} = 25\text{ °C}$			2.1		Ω
输入电容	C_{ISS}	$f = 100\text{ kHz}, V_{DS} = 800\text{ V}, V_{GS} = 0\text{ V}$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$		8.8		nF
输出电容	C_{OSS}	$f = 100\text{ kHz}, V_{DS} = 800\text{ V}, V_{GS} = 0\text{ V}$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$		0.42		nF
反向传输电容	C_{RSS}	$f = 100\text{ kHz}, V_{DS} = 800\text{ V}, V_{GS} = 0\text{ V}$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$		0.028		nF
C_{OSS} 存储能量	E_{OSS}	$V_{DS} = 800\text{ V}, V_{GS} = -3/18\text{ V}, T_{vj} = 25\text{ °C}$			172		μJ
漏源泄漏电流	I_{DSS}	$V_{DS} = 1200\text{ V}, V_{GS} = -3\text{ V}$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$		0.06	380	μA
栅极漏电流	I_{GSS}	$V_{DS} = 0\text{ V}, T_{vj} = 25\text{ °C}$	$V_{GS} = 20\text{ V}$			400	nA
开通延迟时间(感性负载)	$t_{d on}$	$I_D = 100\text{ A}, R_{Gon} = 15\text{ Ω}, V_{DS} = 400\text{ V}, V_{GS} = -3/18\text{ V}$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$		83		ns
			$T_{vj} = 125\text{ °C}$		73		
			$T_{vj} = 175\text{ °C}$		70		
上升时间(感性负载)	t_r	$I_D = 100\text{ A}, R_{Gon} = 15\text{ Ω}, V_{DS} = 400\text{ V}, V_{GS} = -3/18\text{ V}$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$		106		ns
			$T_{vj} = 125\text{ °C}$		111		
			$T_{vj} = 175\text{ °C}$		116		

(待续)

表 5 (续) 特征值

特征参数	代号	标注或测试条件		数值			单位
				最小值	典型值	最大值	
关断延迟时间(感性负载)	$t_{d\ off}$	$I_D = 100\ A, R_{Goff} = 3.3\ \Omega, V_{DS} = 400\ V, V_{GS} = -3/18\ V$		$T_{vj} = 25\ ^\circ C$	74		ns
				$T_{vj} = 125\ ^\circ C$	80		
				$T_{vj} = 175\ ^\circ C$	84		
下降时间(感性负载)	t_f	$I_D = 100\ A, R_{Goff} = 3.3\ \Omega, V_{DS} = 400\ V, V_{GS} = -3/18\ V$		$T_{vj} = 25\ ^\circ C$	17		ns
				$T_{vj} = 125\ ^\circ C$	16		
				$T_{vj} = 175\ ^\circ C$	16		
开通损耗能量(每脉冲)	E_{on}	$I_D = 100\ A, V_{DS} = 400\ V, L_\sigma = 27\ nH, V_{GS} = -3/18\ V, R_{Gon} = 15\ \Omega, di/dt = 2\ kA/\mu s (T_{vj} = 175\ ^\circ C)$		$T_{vj} = 25\ ^\circ C$	3.28		mJ
				$T_{vj} = 125\ ^\circ C$	3.97		
				$T_{vj} = 175\ ^\circ C$	4.33		
关断损耗能量(每脉冲)	E_{off}	$I_D = 100\ A, V_{DS} = 400\ V, L_\sigma = 27\ nH, V_{GS} = -3/18\ V, R_{Goff} = 3.3\ \Omega, dv/dt = 20.1\ kV/\mu s (T_{vj} = 175\ ^\circ C)$		$T_{vj} = 25\ ^\circ C$	0.32		mJ
				$T_{vj} = 125\ ^\circ C$	0.38		
				$T_{vj} = 175\ ^\circ C$	0.42		
结-散热器热阻	R_{thJH}	每个 MOSFET , Valid with IFX pre-applied Thermal Interface Material				0.581	K/W
允许开关的温度范围	$T_{vj\ op}$			-40		175	$^\circ C$

注: The selection of positive and negative gate-source voltages impacts the long-term behavior of the MOSFET and body diode. The design guidelines described in Application Note AN 2018-09 must be considered to ensure sound operation of the device over the planned lifetime.

$T_{vj\ op} > 150\ ^\circ C$ is allowed for operation at overload conditions for MOSFET and body diode. For detailed specifications, please refer to AN 2021-13.

3 Body diode

表 6 最大标定值

特征参数	代号	标注或测试条件		数值	单位
体二极管正向直流电流	I_{SD}	$T_{vj} = 175\ ^\circ C, V_{GS} = -3\ V$	$T_H = 65\ ^\circ C$	32	A

表 7 特征值

特征参数	代号	标注或测试条件		数值			单位
				最小值	典型值	最大值	
正向电压	V_{SD}	$I_{SD} = 100\ A, V_{GS} = -3\ V$		$T_{vj} = 25\ ^\circ C$	4.2	5.35	V
				$T_{vj} = 125\ ^\circ C$	3.9		
				$T_{vj} = 175\ ^\circ C$	3.8		

4 IGBT, 三电平

表 8 最大标定值

特征参数	代号	标注或测试条件		数值	单位
集电极-发射极电压	V_{CES}		$T_{vj} = 25\text{ °C}$	650	V
集电极电流	I_{CN}			200	A
连续集电极直流电流	I_{CDC}	$T_{vj\ max} = 175\text{ °C}$	$T_H = 65\text{ °C}$	90	A
集电极重复峰值电流	I_{CRM}	t_p 受限于 $T_{vj\ op}$		200	A
栅极-发射极峰值电压	V_{GES}			± 20	V

表 9 特征值

特征参数	代号	标注或测试条件	数值			单位	
			最小值	典型值	最大值		
集电极-发射极饱和电压	$V_{CE\ sat}$	$I_C = 100\text{ A}, V_{GE} = 15\text{ V}$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$	0.74	1.17	1.59	V
			$T_{vj} = 125\text{ °C}$		1.20		
			$T_{vj} = 150\text{ °C}$		1.21		
栅极阈值电压	V_{Geth}	$I_C = 2\text{ mA}, V_{CE} = V_{GE}, T_{vj} = 25\text{ °C}$	3.25	4	4.75	V	
栅极电荷	Q_G	$V_{GE} = \pm 15\text{ V}, V_{CE} = 400\text{ V}$		0.84		μC	
内部栅极电阻	R_{Gint}	$T_{vj} = 25\text{ °C}$		0		Ω	
输入电容	C_{ies}	$f = 100\text{ kHz}, T_{vj} = 25\text{ °C}, V_{CE} = 25\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}$		14.3		nF	
反向传输电容	C_{res}	$f = 100\text{ kHz}, T_{vj} = 25\text{ °C}, V_{CE} = 25\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}$		0.05		nF	
集电极-发射极截止电流	I_{CES}	$V_{CE} = 650\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$			1	mA
栅极-发射极漏电流	I_{GES}	$V_{CE} = 0\text{ V}, V_{GE} = 20\text{ V}, T_{vj} = 25\text{ °C}$				100	nA
开通延迟时间(感性负载)	t_{don}	$I_C = 100\text{ A}, V_{CE} = 400\text{ V}, V_{GE} = \pm 15\text{ V}, R_{Gon} = 2.7\ \Omega$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$	0.014			μs
			$T_{vj} = 125\text{ °C}$		0.015		
			$T_{vj} = 150\text{ °C}$		0.015		
上升时间(感性负载)	t_r	$I_C = 100\text{ A}, V_{CE} = 400\text{ V}, V_{GE} = \pm 15\text{ V}, R_{Gon} = 2.7\ \Omega$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$	0.009			μs
			$T_{vj} = 125\text{ °C}$		0.010		
			$T_{vj} = 150\text{ °C}$		0.011		
关断延迟时间(感性负载)	t_{doff}	$I_C = 100\text{ A}, V_{CE} = 400\text{ V}, V_{GE} = \pm 15\text{ V}, R_{Goff} = 39\ \Omega$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$	0.650			μs
			$T_{vj} = 125\text{ °C}$		0.680		
			$T_{vj} = 150\text{ °C}$		0.700		
下降时间(感性负载)	t_f	$I_C = 100\text{ A}, V_{CE} = 400\text{ V}, V_{GE} = \pm 15\text{ V}, R_{Goff} = 39\ \Omega$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$	0.023			μs
			$T_{vj} = 125\text{ °C}$		0.045		
			$T_{vj} = 150\text{ °C}$		0.055		

(待续)

表 9 (续) 特征值

特征参数	代号	标注或测试条件		数值			单位
				最小值	典型值	最大值	
开通损耗能量 (每脉冲)	E_{on}	$I_C = 100\text{ A}, V_{CE} = 400\text{ V},$ $L_\sigma = 27\text{ nH}, V_{GE} = \pm 15\text{ V},$ $R_{Gon} = 2.7\ \Omega, di/dt =$ $7600\text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj} = 150\text{ }^\circ\text{C})$		$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$	0.264		mJ
				$T_{vj} = 125\text{ }^\circ\text{C}$	0.394		
				$T_{vj} = 150\text{ }^\circ\text{C}$	0.438		
关断损耗能量 (每脉冲)	E_{off}	$I_C = 100\text{ A}, V_{CE} = 400\text{ V},$ $L_\sigma = 27\text{ nH}, V_{GE} = \pm 15\text{ V},$ $R_{Goff} = 39\ \Omega, dv/dt =$ $4800\text{ V}/\mu\text{s} (T_{vj} = 150\text{ }^\circ\text{C})$		$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$	1.7		mJ
				$T_{vj} = 125\text{ }^\circ\text{C}$	2.05		
				$T_{vj} = 150\text{ }^\circ\text{C}$	2.31		
结-散热器热阻	R_{thJH}	每个 IGBT, Valid with IFX pre-applied Thermal Interface Material				0.723	K/W
允许开关的温度范围	T_{vjop}			-40		150	$^\circ\text{C}$

5 二极管, 三电平

表 10 最大标定值

特征参数	代号	标注或测试条件		数值	单位	
反向重复峰值电压	V_{RRM}		$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$	650	V	
正向电流	I_{FN}			150	A	
连续正向直流电流	I_F			100	A	
正向重复峰值电流	I_{FRM}	$t_p = 1\text{ ms}$		200	A	
I^2t -值	I^2t	$V_R = 0\text{ V}, t_p = 10\text{ ms}$		$T_{vj} = 125\text{ }^\circ\text{C}$	1270	A^2s
				$T_{vj} = 150\text{ }^\circ\text{C}$	1480	

表 11 特征值

特征参数	代号	标注或测试条件		数值			单位	
				最小值	典型值	最大值		
正向电压	V_F	$I_F = 100\text{ A}, V_{GE} = 0\text{ V}$		$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$	0.74	1.35	1.86	V
				$T_{vj} = 125\text{ }^\circ\text{C}$		1.29		
				$T_{vj} = 150\text{ }^\circ\text{C}$		1.25		
反向恢复峰值电流	I_{RM}	$I_F = 100\text{ A}, V_R = 400\text{ V},$ $V_{GE} = -15\text{ V}, -di_F/dt =$ $2000\text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj} = 150\text{ }^\circ\text{C})$		$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$		64.2		A
				$T_{vj} = 125\text{ }^\circ\text{C}$		99.8		
				$T_{vj} = 150\text{ }^\circ\text{C}$		114		

(待续)

表 11 (续) 特征值

特征参数	代号	标注或测试条件	数值			单位
			最小值	典型值	最大值	
恢复电荷	Q_r	$I_F = 100 \text{ A}, V_R = 400 \text{ V}, V_{GE} = -15 \text{ V}, -di_F/dt = 2000 \text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj} = 150 \text{ }^\circ\text{C})$	$T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$	3.99		μC
			$T_{vj} = 125 \text{ }^\circ\text{C}$	7.07		
			$T_{vj} = 150 \text{ }^\circ\text{C}$	9.8		
反向恢复损耗 (每脉冲)	E_{rec}	$I_F = 100 \text{ A}, V_R = 400 \text{ V}, V_{GE} = -15 \text{ V}, -di_F/dt = 2000 \text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj} = 150 \text{ }^\circ\text{C})$	$T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$	0.45		mJ
			$T_{vj} = 125 \text{ }^\circ\text{C}$	1		
			$T_{vj} = 150 \text{ }^\circ\text{C}$	1.35		
结-散热器热阻	R_{thJH}	每个二极管, Valid with IFX pre-applied Thermal Interface Material			0.802	K/W
允许开关的温度范围	$T_{vj op}$		-40		150	$^\circ\text{C}$

6 负温度系数热敏电阻

表 12 特征值

特征参数	代号	标注或测试条件	数值			单位
			最小值	典型值	最大值	
额定电阻值	R_{25}	$T_{NTC} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$		5		k Ω
R_{100} 偏差	$\Delta R/R$	$T_{NTC} = 100 \text{ }^\circ\text{C}, R_{100} = 493 \text{ } \Omega$	-5		5	%
耗散功率	P_{25}	$T_{NTC} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$			20	mW
B-值	$B_{25/50}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/50}(1/T_2 - 1/(298,15 \text{ K}))]$		3375		K
B-值	$B_{25/80}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/80}(1/T_2 - 1/(298,15 \text{ K}))]$		3411		K
B-值	$B_{25/100}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/100}(1/T_2 - 1/(298,15 \text{ K}))]$		3433		K

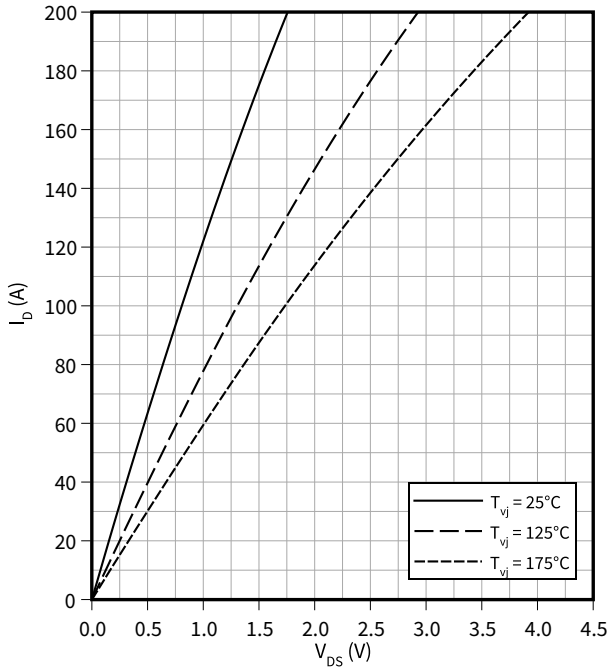
注: 根据应用手册标定

7 特征参数图表

output characteristic (typical), MOSFET

$I_D = f(V_{DS})$

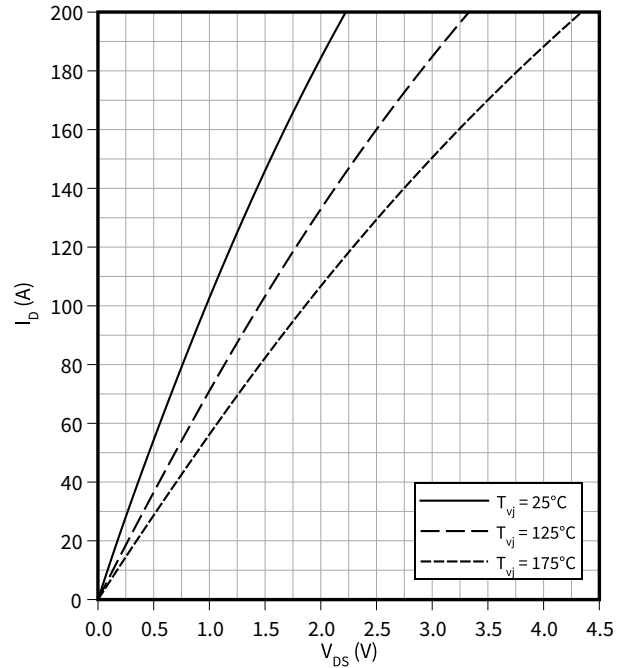
$V_{GS} = 18\text{ V}$



output characteristic (typical), MOSFET

$I_D = f(V_{DS})$

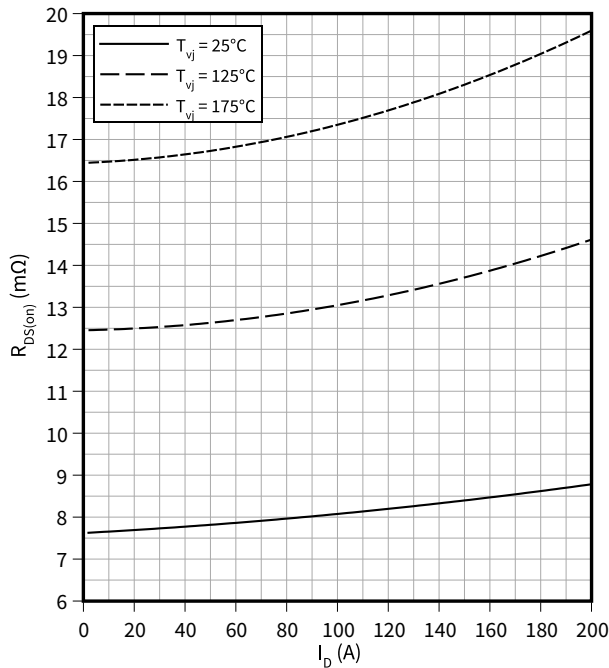
$V_{GS} = 15\text{ V}$



漏源通态电阻 (典型), MOSFET

$R_{DS(on)} = f(I_D)$

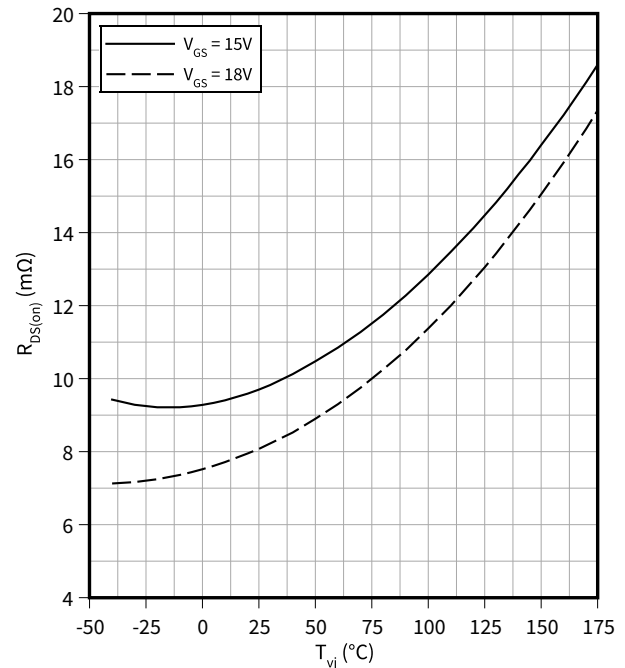
$V_{GS} = 18\text{ V}$



漏源通态电阻 (典型), MOSFET

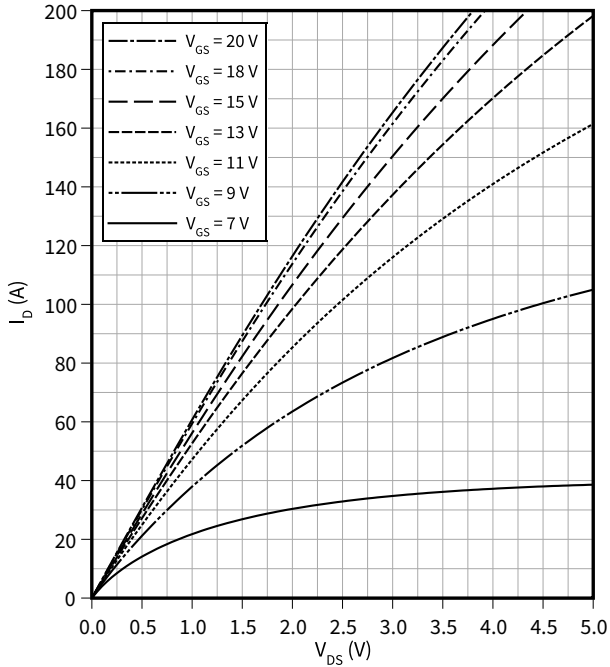
$R_{DS(on)} = f(T_{vj})$

$I_D = 100\text{ A}$



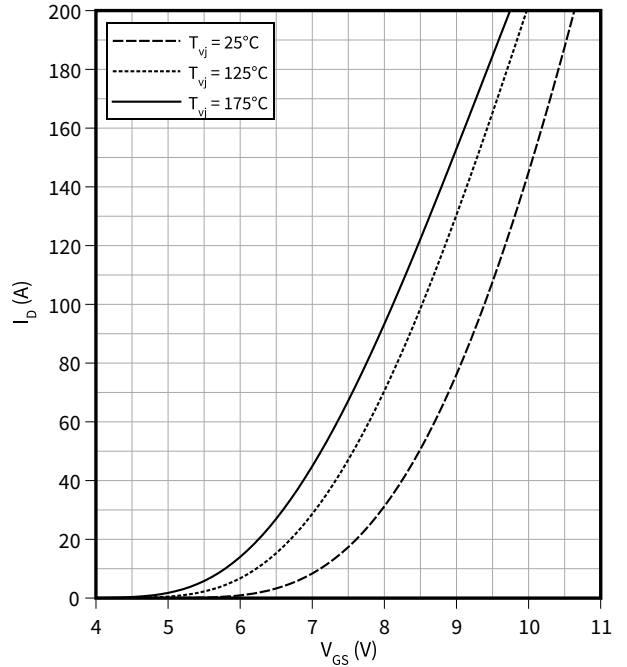
输出特性 (典型), MOSFET

$I_D = f(V_{DS})$
 $T_{vj} = 175\text{ °C}$



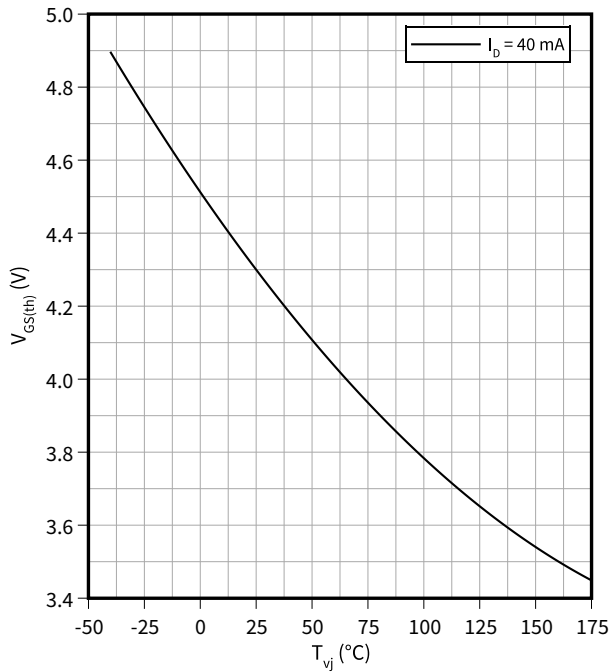
传输特性 (典型), MOSFET

$I_D = f(V_{GS})$
 $V_{DS} = 20\text{ V}$



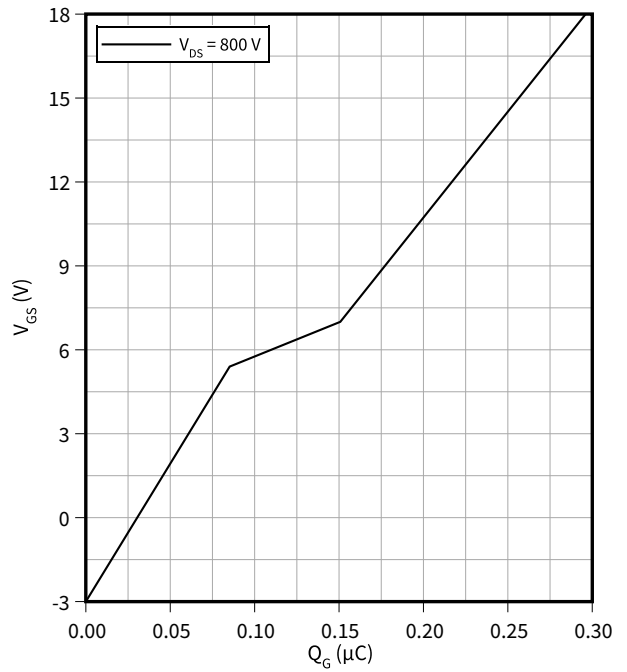
栅-源阈值电压 (典型), MOSFET

$V_{GS(th)} = f(T_{vj})$
 $V_{GS} = V_{DS}$



栅极电荷特性 (典型), MOSFET

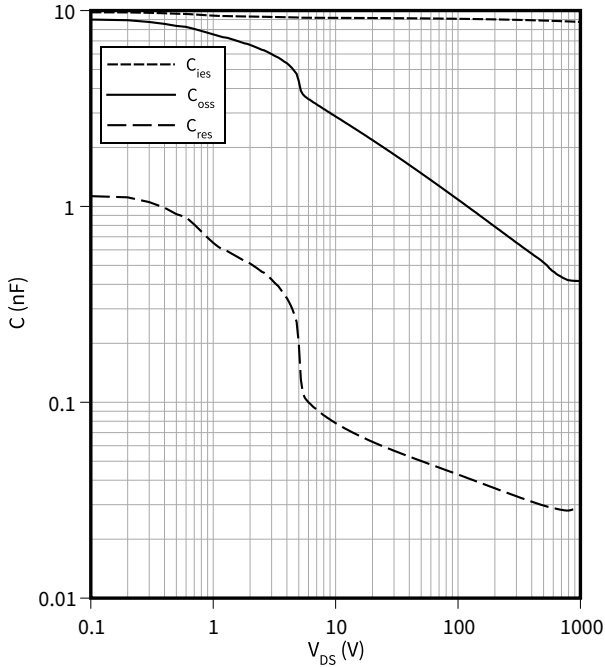
$V_{GS} = f(Q_G)$
 $I_D = 100\text{ A}, T_{vj} = 25\text{ °C}$



电容特性 (典型), MOSFET

$C = f(V_{DS})$

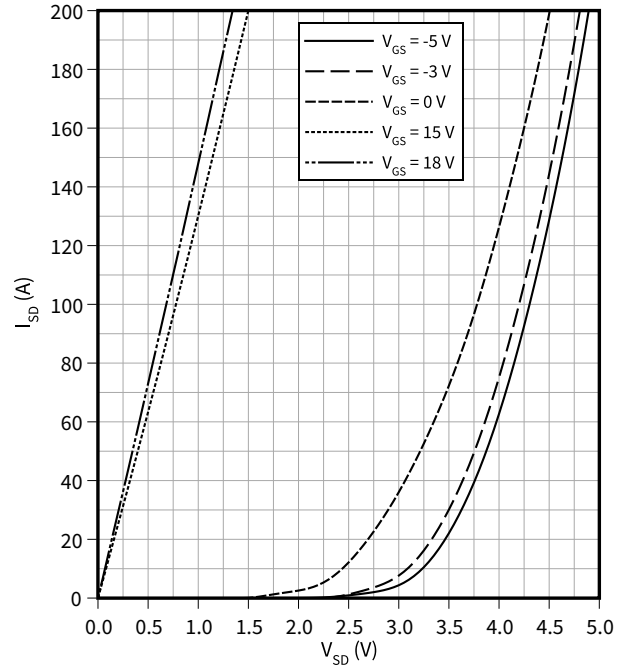
$f = 100 \text{ kHz}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}, V_{GS} = 0 \text{ V}$



正向特性 体二极管 (典型), MOSFET

$I_{SD} = f(V_{SD})$

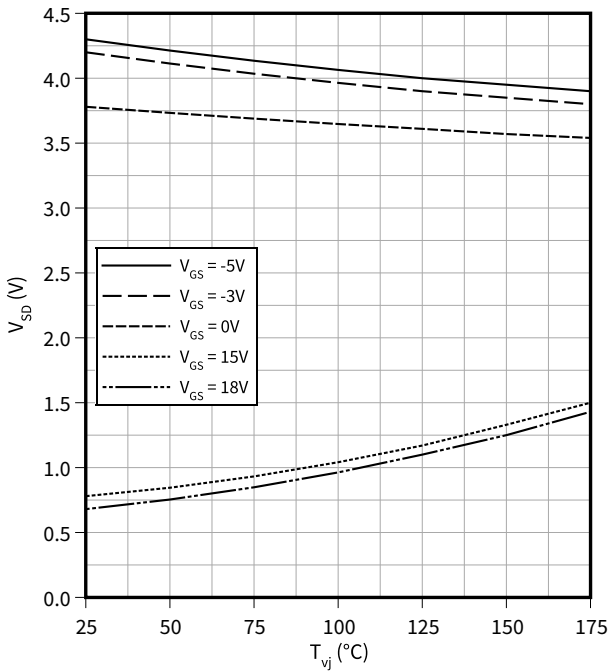
$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$



体二极管正向压降 (典型), MOSFET

$V_{SD} = f(T_{vj})$

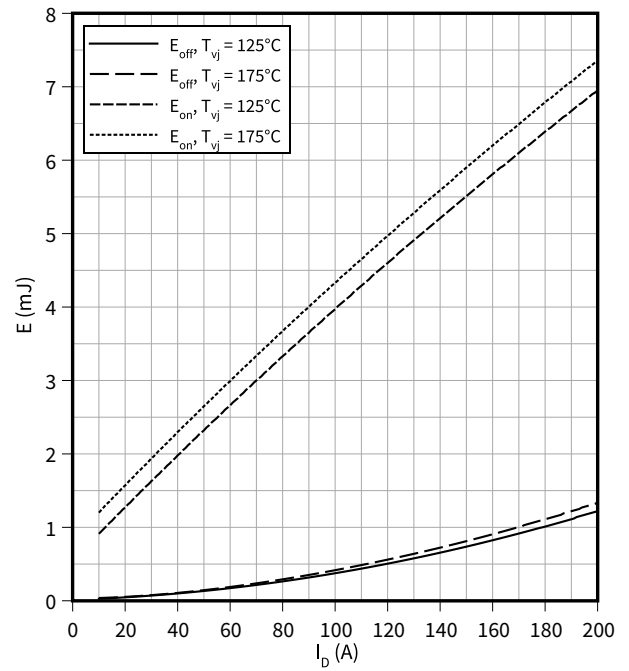
$I_{SD} = 100 \text{ A}$



开关损耗 (典型), MOSFET

$E = f(I_D)$

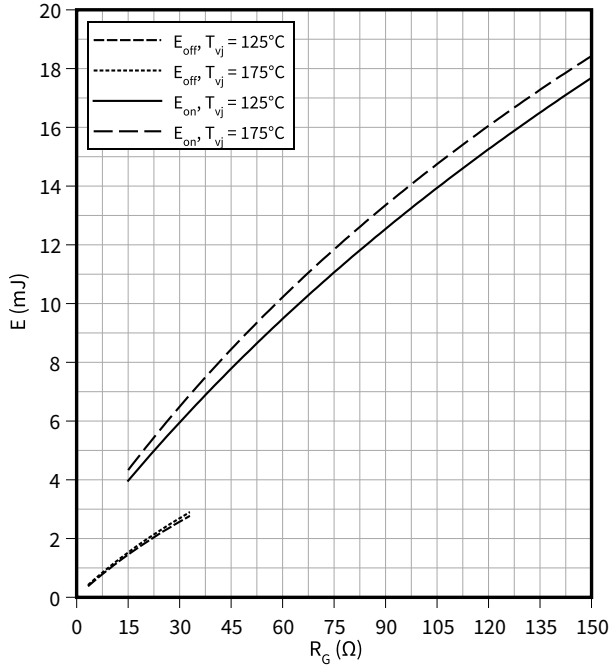
$R_{Goff} = 3.3 \Omega, R_{Gon} = 15 \Omega, V_{DS} = 400 \text{ V}, V_{GS} = -3/18 \text{ V}$



开关损耗 (典型), MOSFET

$E = f(R_G)$

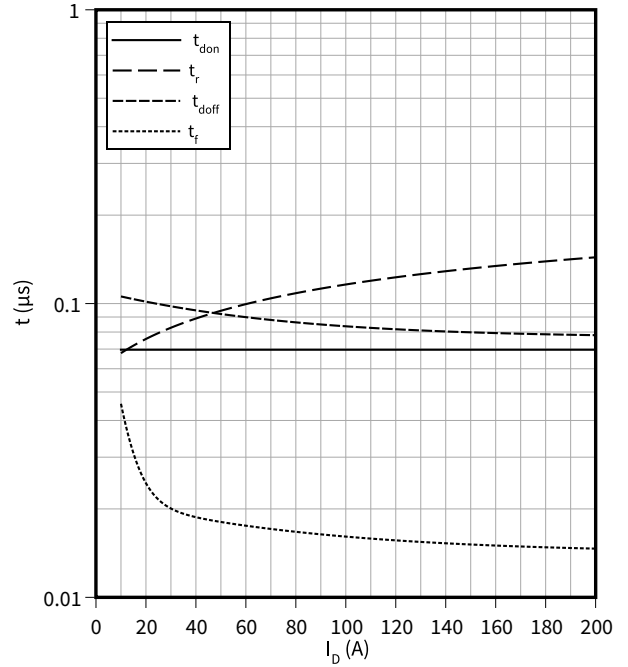
$V_{DS} = 400\text{ V}, I_D = 100\text{ A}, V_{GS} = -3/18\text{ V}$



开关时间 (典型), MOSFET

$t = f(I_D)$

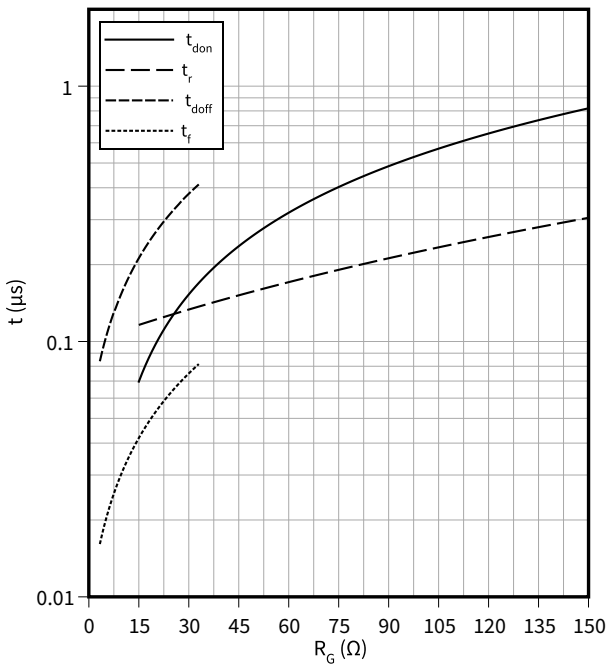
$R_{Goff} = 3.3\ \Omega, R_{Gon} = 15\ \Omega, V_{DS} = 400\text{ V}, T_{vj} = 175\text{ }^\circ\text{C}, V_{GS} = -3/18\text{ V}$



开关时间 (典型), MOSFET

$t = f(R_G)$

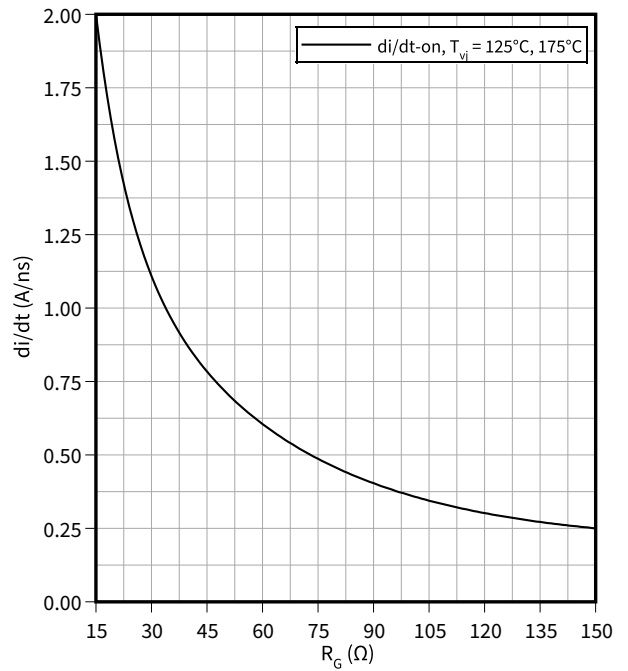
$V_{DS} = 400\text{ V}, I_D = 100\text{ A}, T_{vj} = 175\text{ }^\circ\text{C}, V_{GS} = -3/18\text{ V}$



电流变化斜率 (典型), MOSFET

$di/dt = f(R_G)$

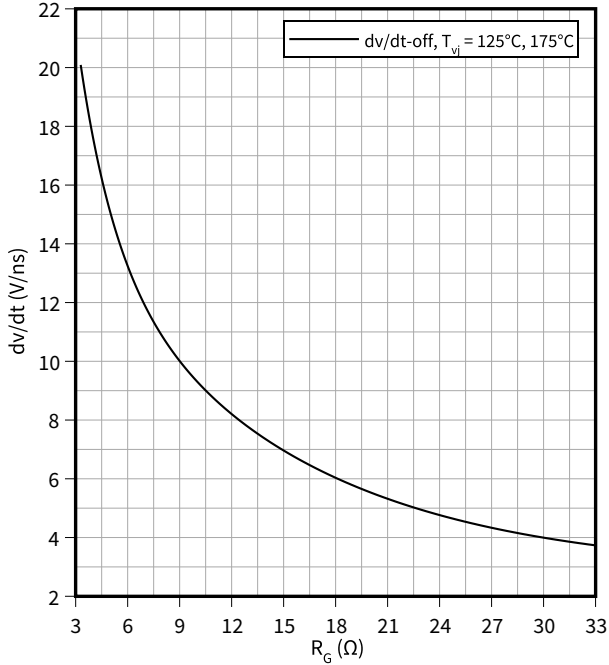
$V_{DS} = 400\text{ V}, I_D = 100\text{ A}, V_{GS} = -3/18\text{ V}$



电压变化斜率 (典型), MOSFET

$dv/dt = f(R_G)$

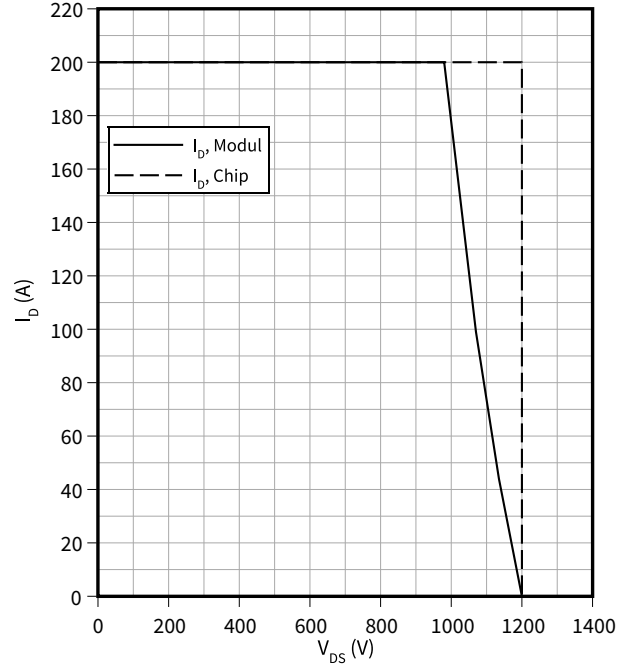
$V_{DS} = 400\text{ V}$, $I_D = 100\text{ A}$, $V_{GS} = -3/18\text{ V}$



反偏安全工作区 (RBSOA), MOSFET

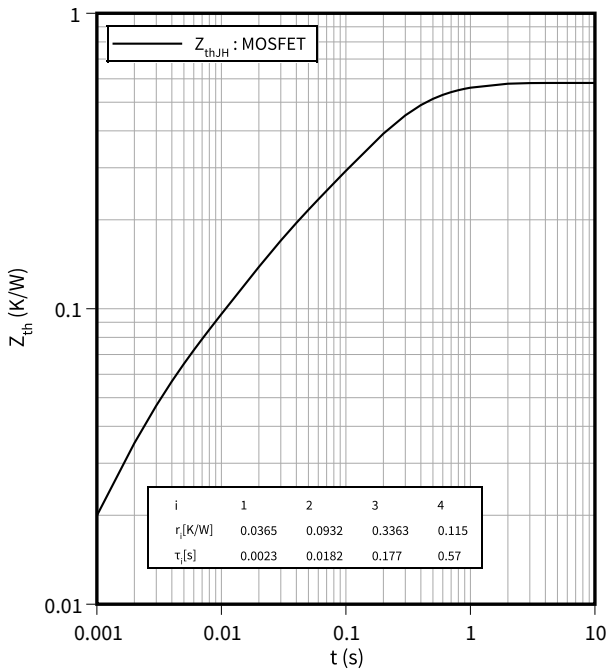
$I_D = f(V_{DS})$

$R_{Goff} = 3.3\ \Omega$, $T_{vj} = 175\ ^\circ\text{C}$, $V_{GS} = -3/18\text{ V}$



瞬态热阻抗, MOSFET

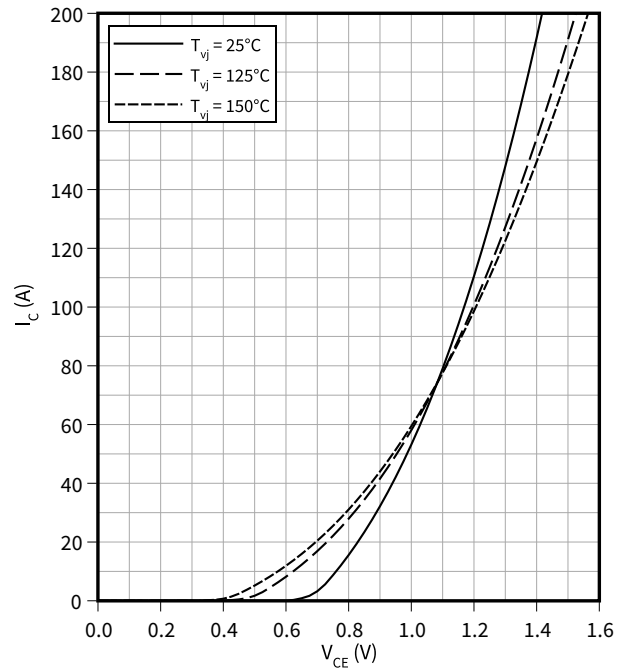
$Z_{th} = f(t)$



输出特性 (典型), IGBT, 三电平

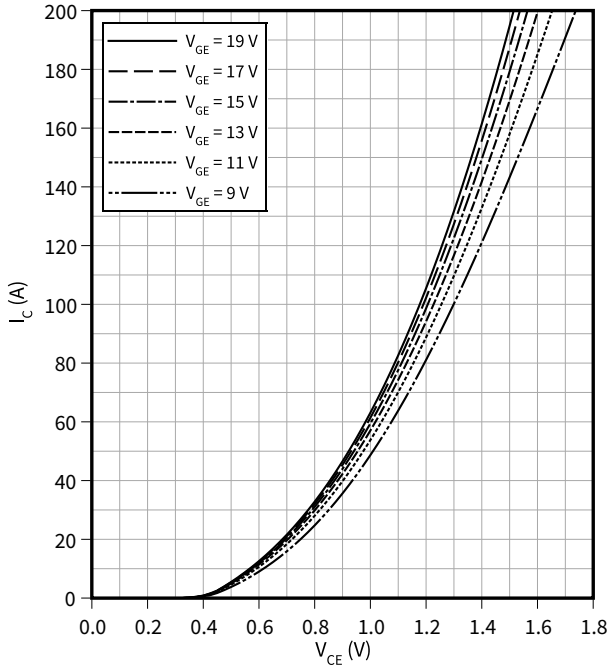
$I_C = f(V_{CE})$

$V_{GE} = 15\text{ V}$



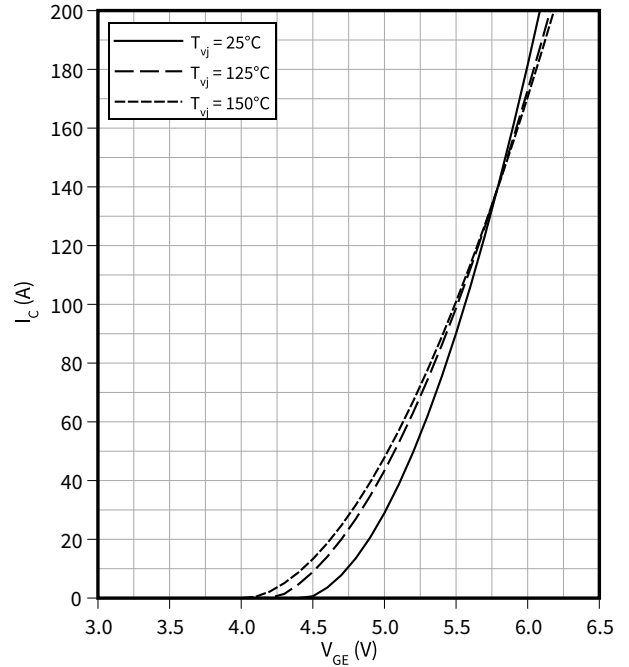
输出特性 (典型), IGBT, 三电平

$I_C = f(V_{CE})$
 $T_{vj} = 150^\circ\text{C}$



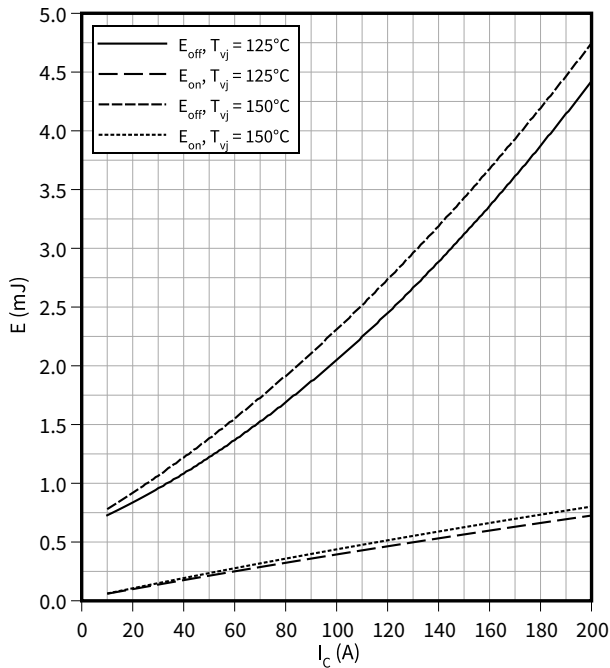
传输特性 (典型), IGBT, 三电平

$I_C = f(V_{GE})$
 $V_{CE} = 20\text{ V}$



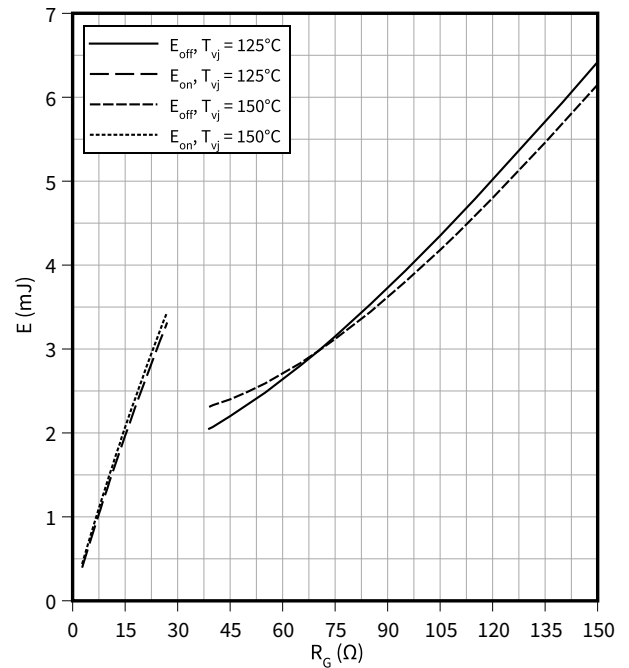
开关损耗 (典型), IGBT, 三电平

$E = f(I_C)$
 $R_{Goff} = 39\ \Omega$, $R_{Gon} = 2.7\ \Omega$, $V_{CE} = 400\text{ V}$, $V_{GE} = -15 / +15\text{ V}$



开关损耗 (典型), IGBT, 三电平

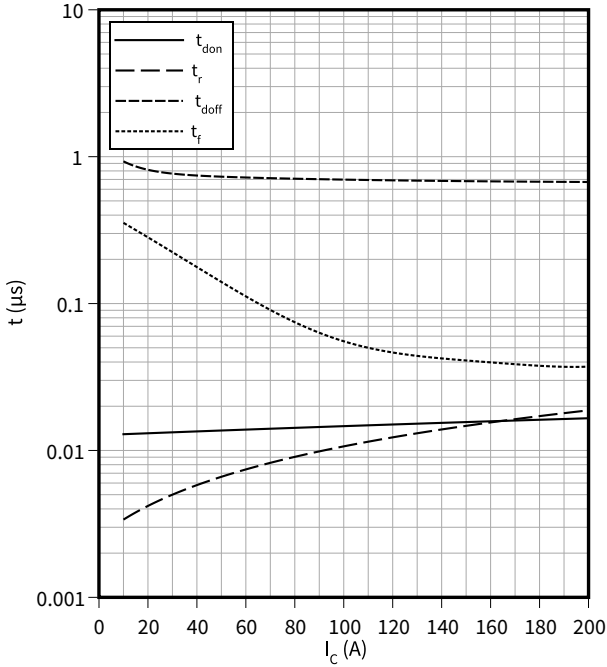
$E = f(R_G)$
 $I_C = 100\text{ A}$, $V_{CE} = 400\text{ V}$, $V_{GE} = -15 / +15\text{ V}$



开关时间 (典型), IGBT, 三电平

$t = f(I_C)$

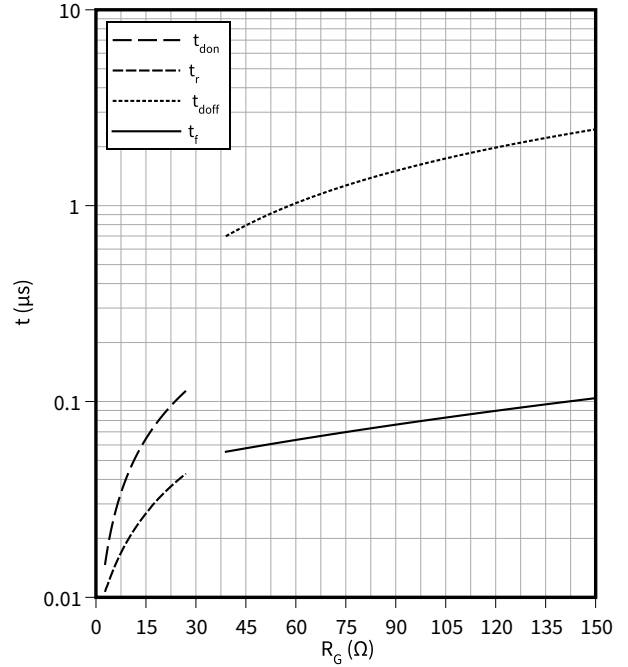
$R_{Goff} = 39 \Omega$, $R_{Gon} = 2.7 \Omega$, $R_{Gon} = 2.7 \Omega$, $V_{CE} = 400 \text{ V}$, $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$, $T_{vj} = 150 \text{ }^\circ\text{C}$



开关时间 (典型), IGBT, 三电平

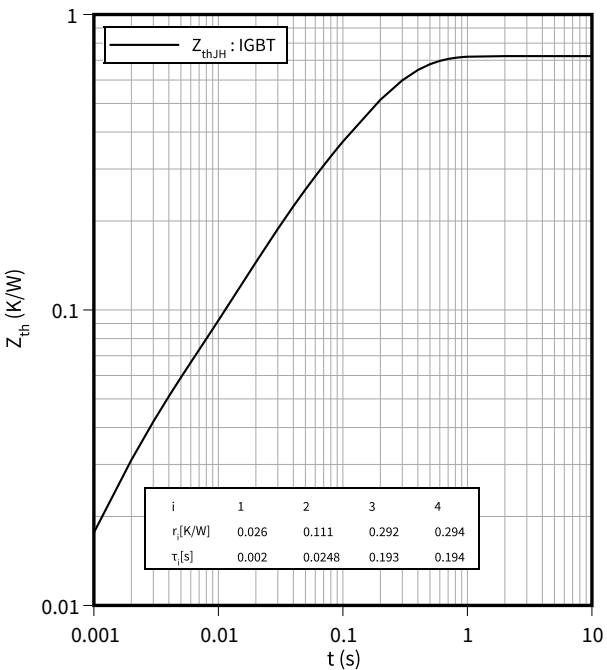
$t = f(R_G)$

$I_C = 100 \text{ A}$, $V_{CE} = 400 \text{ V}$, $V_{GE} = -15 / +15 \text{ V}$, $T_{vj} = 150 \text{ }^\circ\text{C}$



瞬态热阻抗, IGBT, 三电平

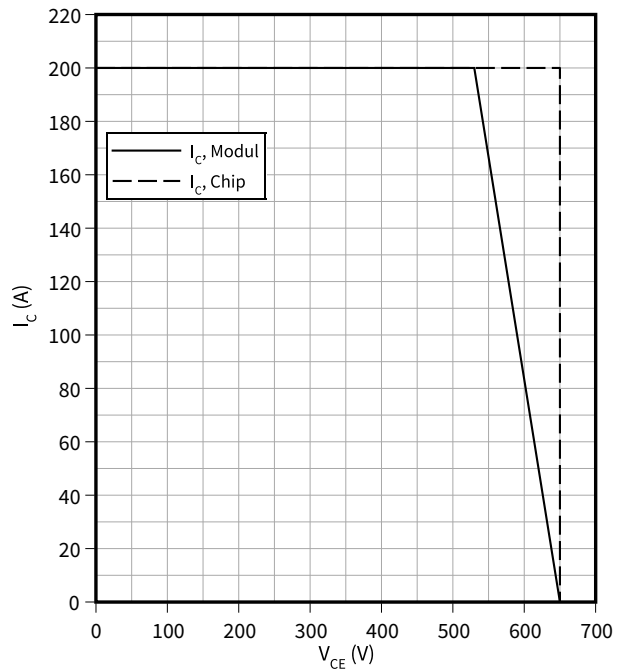
$Z_{th} = f(t)$



反偏安全工作区 (RBSOA), IGBT, 三电平

$I_C = f(V_{CE})$

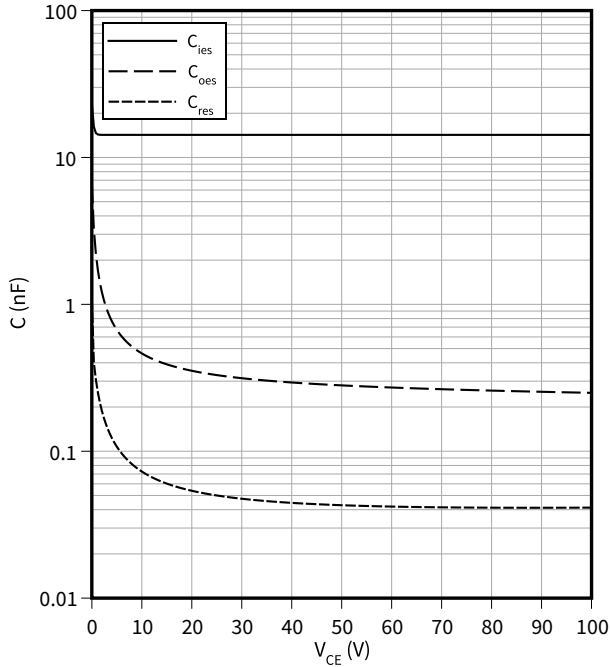
$T_{vj} = 150 \text{ }^\circ\text{C}$, $R_{Goff} = 39 \Omega$, $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$



电容特性 (典型), IGBT, 三电平

$$C = f(V_{CE})$$

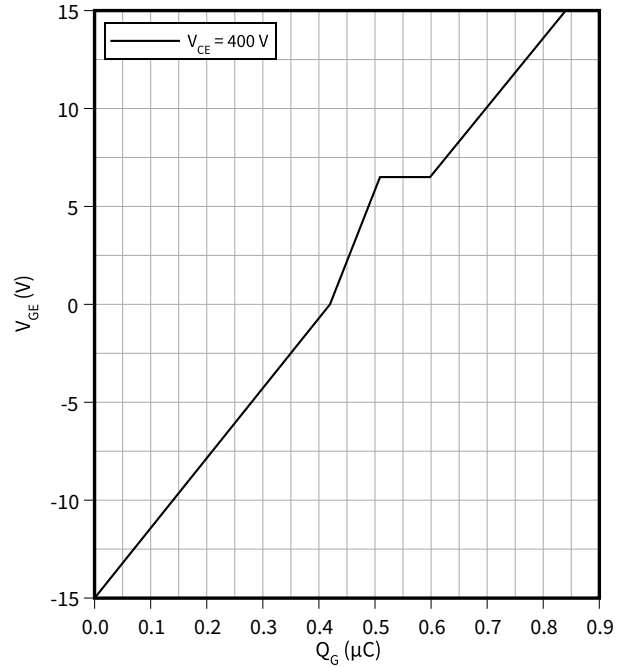
$f = 100 \text{ kHz}, V_{GE} = 0 \text{ V}, T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$



栅极电荷特性 (典型), IGBT, 三电平

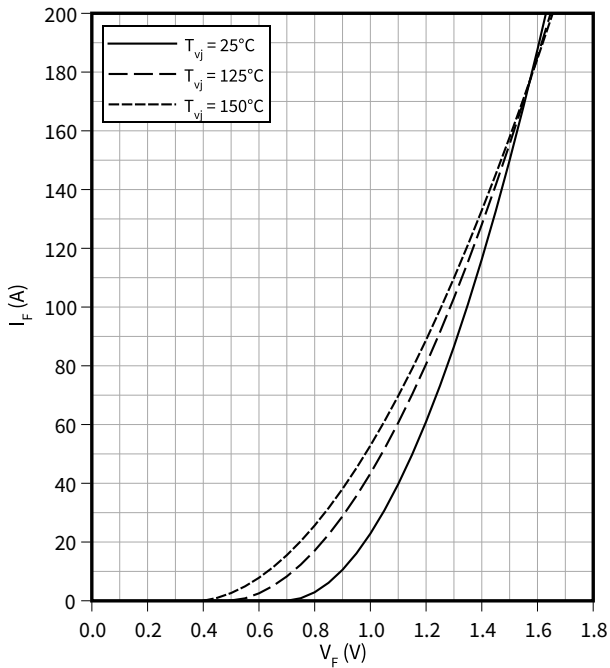
$$V_{GE} = f(Q_G)$$

$I_C = 100 \text{ A}, T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$



正向特性 (典型), 二极管, 三电平

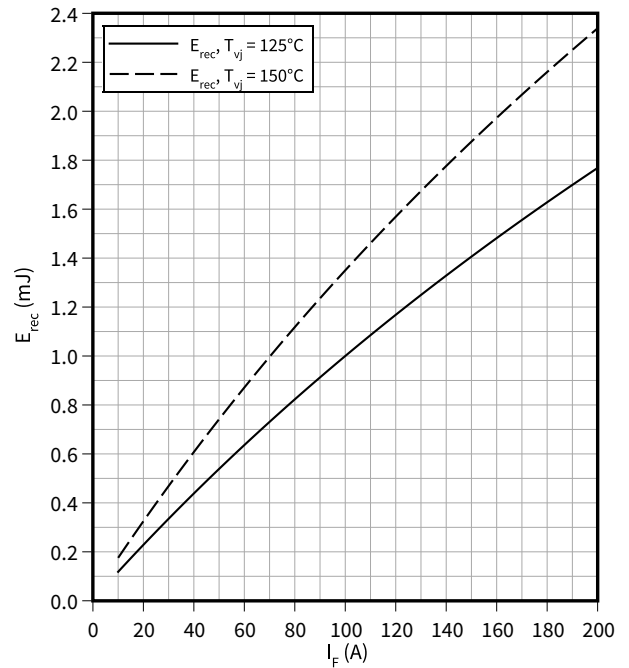
$$I_F = f(V_F)$$



开关损耗 (典型), 二极管, 三电平

$$E_{rec} = f(I_F)$$

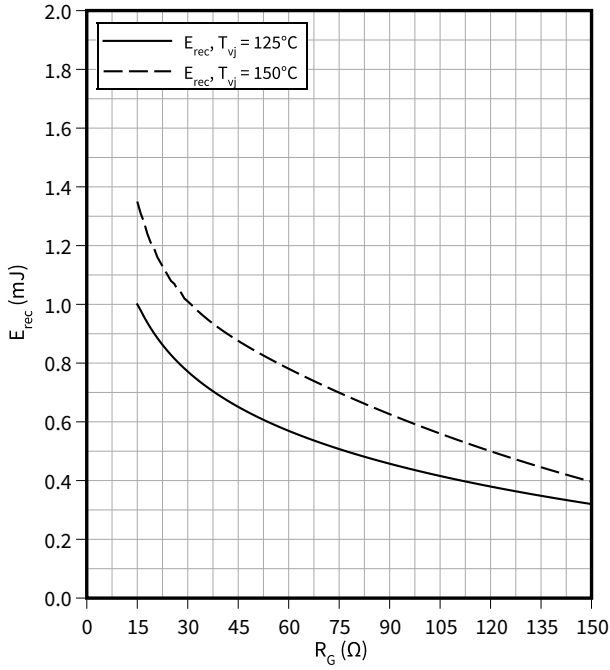
$R_G = 15 \text{ } \Omega, V_R = 400 \text{ V}$



开关损耗 (典型), 二极管, 三电平

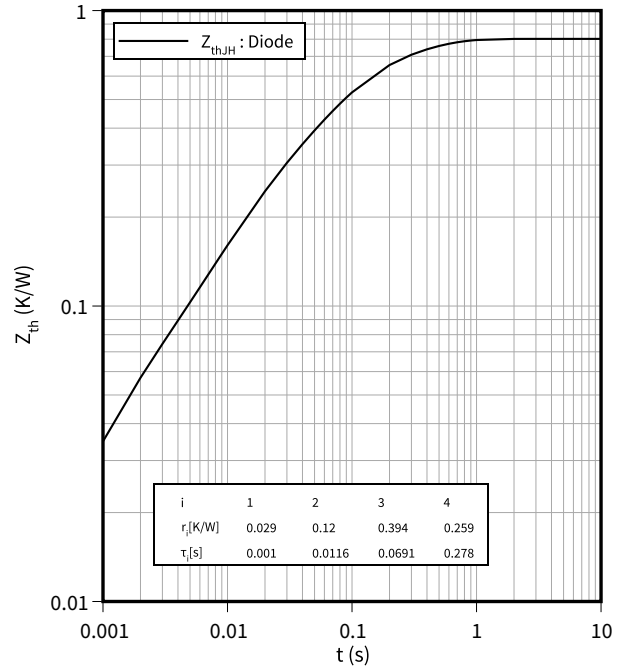
$E_{rec} = f(R_G)$

$I_F = 100 \text{ A}, V_R = 400 \text{ V}$



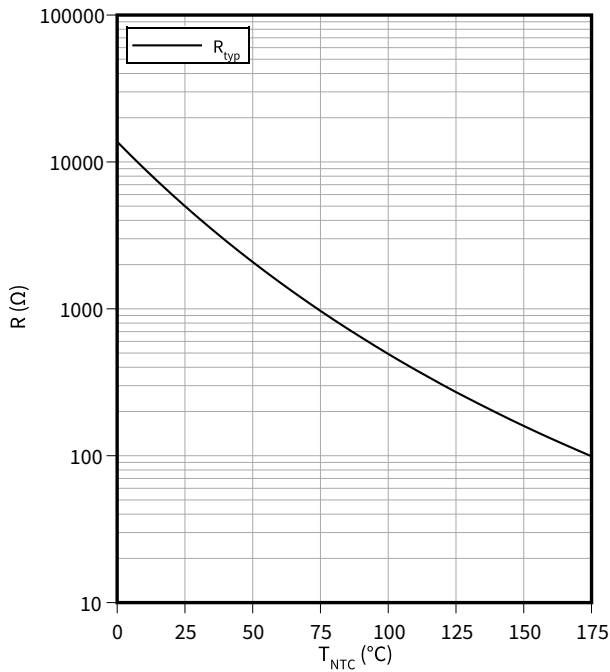
瞬态热阻抗, 二极管, 三电平

$Z_{th} = f(t)$



温度特性, 负温度系数热敏电阻

$R = f(T_{NTC})$



8 电路拓扑图

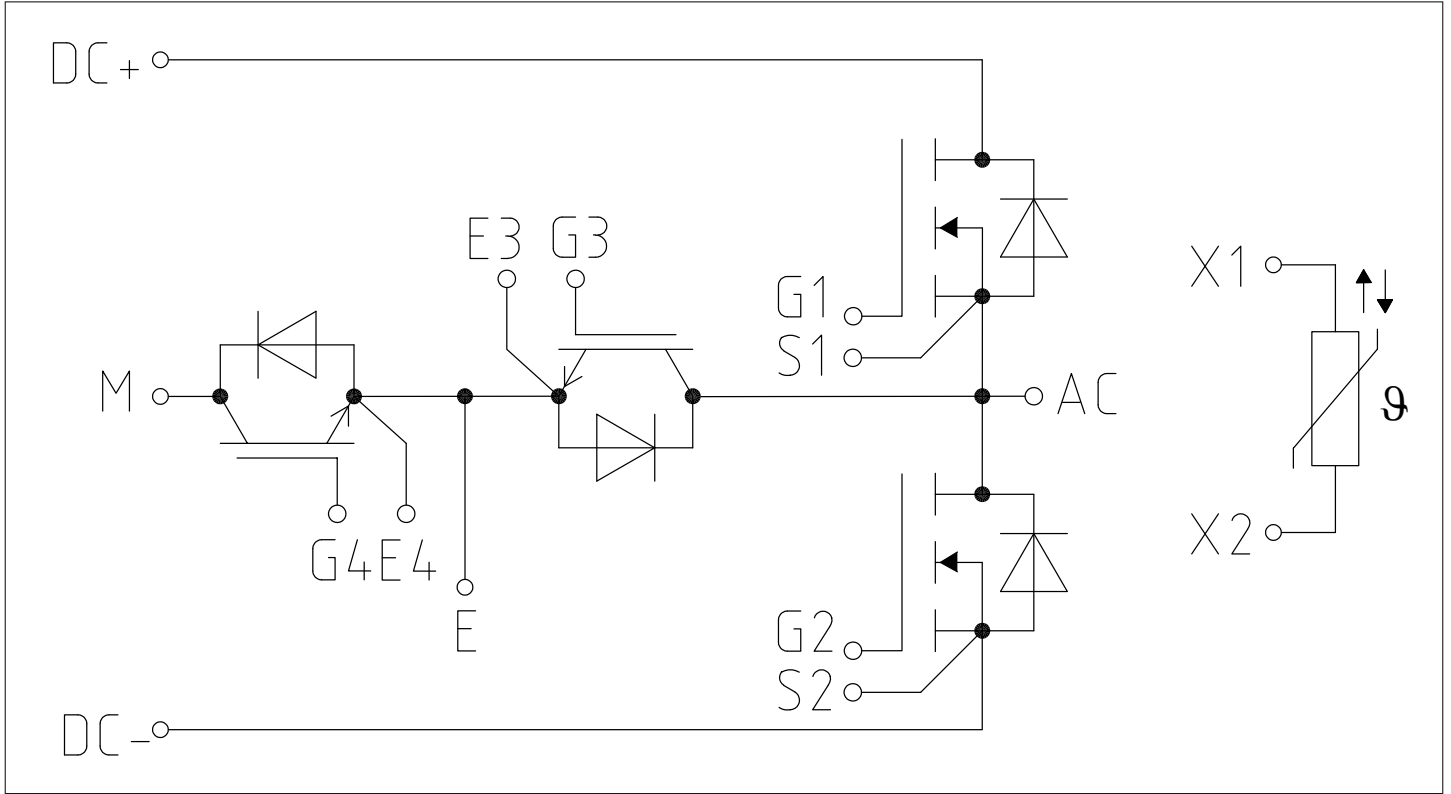


图 1

9 封装尺寸

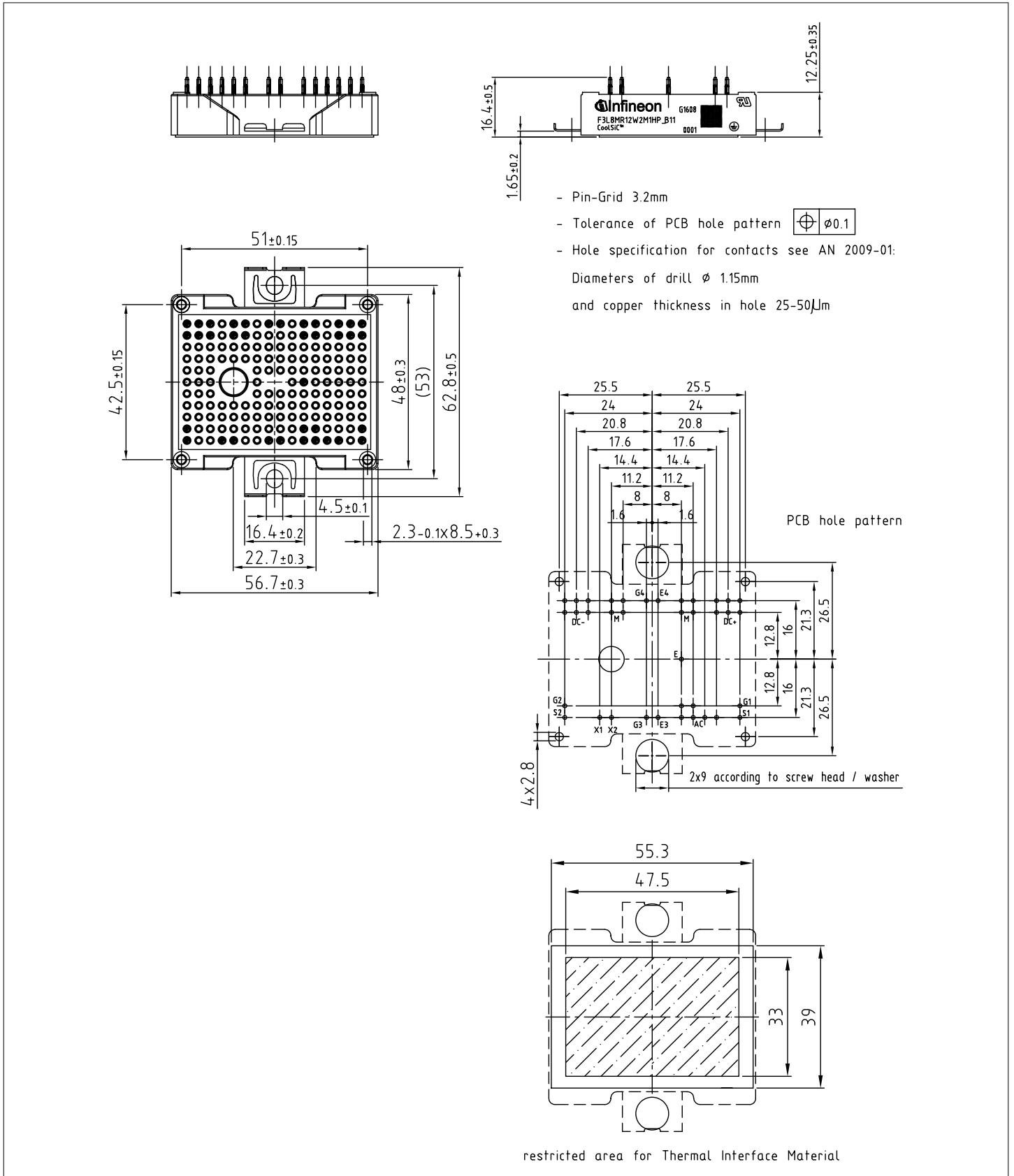


图 2

10 模块标签代码


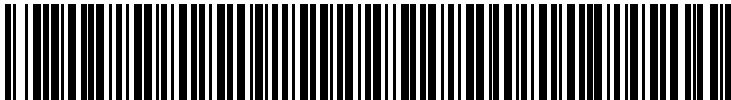
Module label code			
Code format	Data Matrix	Barcode Code128	
Encoding	ASCII text	Code Set A	
Symbol size	16x16	23 digits	
Standard	IEC24720 and IEC16022	IEC8859-1	
Code content	<i>Content</i>	<i>Digit</i>	<i>Example</i>
	Module serial number	1 - 5	71549
	Module material number	6 - 11	142846
	Production order number	12 - 19	55054991
	Date code (production year)	20 - 21	15
	Date code (production week)	22 - 23	30
Example	 		
	71549142846550549911530		71549142846550549911530

图 3

修订历史

修订版本	发布日期	变更说明
0.10	2021-04-07	
1.00	2022-03-09	Final datasheet
1.10	2022-03-11	Final datasheet

商标

所有参照产品或服务名称和商标均为其各自所有者的财产。

版本 2022-03-11

出版方

Infineon Technologies AG

81726 Munich, Germany

© 2022 Infineon Technologies AG

保留所有权利。

您对本文档的内容有任何疑问吗？

电子邮件: erratum@infineon.com

文档编号

IFX-ABA497-003

重要提示

本文档所提供的任何信息绝不应被视为针对任何条件或者品质而做出的保证（质量保证）。

英飞凌对于本文档中所提及的任何事例、提示或者任何特定数值及/或任何关于产品应用方面的信息均在此明确声明其不承担任何保证或者责任，包括但不限于其不侵犯任何第三方知识产权的保证均在此排除。

此外，本文档所提供的任何信息均取决于客户履行本文档所载明的义务和客户遵守适用于客户产品以及与客户对于英飞凌产品的应用所相关的任何法律要求、规范和标准。

本文档所含的数据仅供经过专业技术培训的人员使用。客户自身的技术部门有义务对于产品是否适宜于其预期的应用和针对该等应用而言本文档中所提供的信息是否充分自行予以评估。

请注意本产品不符合汽车电子协会制定的车电可靠度验证 AEC Q 100 或 AEC Q101 标准的要求。

警告事项

由于技术所需产品可能含有危险物质。如需了解该等物质的类型，请向离您最近的英飞凌科技办公室接洽。

除非由经英飞凌科技授权代表签署的书面文件中做出另行明确批准的情况外，英飞凌科技的产品不应被用于任何一项一旦产品失效或者产品使用的后当被用于任何一项一旦产品失效或者产品使用的后领域。